PACS: 61.46.+w, 85.42.+m

Д.В. Батов¹, В.Д. Бланк¹, Е.В. Поляков¹, Б.А. Кульницкий¹, Б.К. Джу²

УГЛЕРОД-АЗОТНЫЕ НАНОТРУБКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ГАЗОСТАТЕ, И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ХОЛОДНЫХ КАТОДОВ

¹ФГУ «ТИСНУМ»

ул. Центральная, 7а, г. Троицк, 142190, Московская обл., Россия

²Корейский институт науки и технологий 131, Cheongriang, Seoul, 130-650, Korea E-mail: batov@isan.troitsk.ru, dvbatov@mail.ru

Исследованы углерод-азотные (CN) нановолокна, синтезированные в газостате. Диаметр нановолокон 100–150 nm. Содержание азота в наноструктурах, определенное методом спектроскопии потерь энергии электронов (EELS), составляет до 13%. При измерении эмиссионных характеристик CN-наноструктуры показали пороговую напряженность поля 1.4 V/µm, что является лучшим результатом для CN-наноструктур и совпадает с лучшими значениями для углеродных нанотрубок. При проведении испытаний на долговременную стабильность падение эмиссионного тока за 100 h непрерывной работы составило менее 10%.

Углеродные наноструктуры, и в частности углеродные нанотрубки, впервые исследованные Ииджимой в 1991 г. [1], являются аллотропной формой углерода, характеризующейся высокой степенью кривизны боковой поверхности, хорошей химической стабильностью, механической прочностью и малой работой выхода. Они привлекают внимание исследователей как материал для изготовления острийных катодов в светоизлучающих элементах [2]. Углеродные нанотрубки и другие наноструктуры способны давать высокую (до 1 A/cm²) плотность тока эмиссии при низкой (< 5 V/µm) напряженности поля. При этом такие показатели наблюдаются не только у чисто углеродных наноструктур, но и в случае CN-наноматериалов. В [3] приводятся данные, что CN-нанотрубки из газовой фазы с горячей нитью (Hot Filament Plasma enhanced CVD), имели пороговую напряженность поля для возникновения эмиссии ниже 3 V/µm.

В представленной работе мы получали СN-наноструктуры в газостате и исследовали их эмиссионные свойства.

СN-наноструктуры (нанотрубки и нановолокна) синтезировали в газостате с использованием в качестве газовой среды азота или смеси азот–аргон при общем давлении в системе 75 MPa. В качестве источника углерода применяли графито-

вый нагреватель. Детальное описание процесса синтеза CN-наноструктур приведено в [4,5]. Полученный осадок исследовали методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей ПЭМ с использованием установок JEM-20CX, CM20 Philips TEM, VG 601 UX STEM и Hitachi S-4300. Также изучали ИК-спектры наноматериалов на фурье-спектрометре Brucker IFS-113.

Для исследования эмиссионных свойств СN-наноструктур на пластину из натрового стекла наносили слой хрома. Катодную поверхность на основе CNнаноструктур создавали впечатыванием (вдавливанием) последних в слой хрома. Анодом служило стекло, покрытое пленкой из смеси оксидов индия и олова с нанесенным люминофором (зеленый фосфор). Измерения эмиссионных свойств проводили в вакуумной камере при давлении 10⁻⁹ MPa. В качестве источника постоянного тока использовали установку производства «F.u.G. Electronic». Эмиссионные характеристики CN-наноструктур измеряли при 300 К.

Исследования методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) показали, что исходный CN-наноматериал представляет собой войлокоподобную массу, состоящую из нанотрубок и нановолокон со случайной ориентацией. Диаметр наноструктур находится в пределах 100–150 nm, длина каждого нановолокна (нанотрубки) – более 10 µm (рис. 1). Увеличение парциального давления азота в системе при неизменности величины общего давления приводило к усилению морфологических различий наноструктур в осадке. Это может объясняться усилением конвекции в результате изменения газодинамических параметров газовой среды, что может приводить к увеличению массопереноса и флуктуаций температуры в зоне роста CN-наноструктур.

При изучении CN-наноструктур на просвечивающем электронном микроскопе было установлено, что в полученном материале присутствуют бамбукоподобные нановолокна с равномерно расположенными внутренними перегородками (BL), бусоподобные наноструктуры (BdL), нанотрубки с тонкими внутренними стенками и нановолокна с тонкими, не полностью сформировавшимися стенками (Cor-трубки) (рис. 2). Исследования методом EELS показали, что содержание азота в наноструктурах различно и составляет 3–4% в BL-волокнах, до 8.5% – в BdL-волокнах и до 13% – в Cor-трубках.



Рис. 1. РЭМ-изображения СN-наноматериала: *a* – ×4000, *б* – ×18000







Рис. 2. ПЭМ-микрофотографии СN-наноструктур: *а* – BdL-наноструктуры, *б* – BL-нановолокна, *в* – Сог-трубки

ИК-спектр CN-наноматериала представлен на рис. 3. Видно, что в наноматериале превалируют одиночные C–N-связи. Полоса в области 1100 cm⁻¹ обычно относится исследователями к вибрационной составляющей одиночной C–N-связи [6]. Имеются публикации [7], что наличие в материале преобладающего количества одиночных C–N-связей по сравнению с двойными и тройными может быть благоприятно для эмиссионных свойств материала.



Рис. 3. ИК-спектр СМ-наноматериала

Рис. 4. Долговременная стабильность эмиссионного тока катода из CN-нанотрубок (ускоряющее напряжение 1500 V)

При изучении эмиссионных характеристик CN-наноструктур определяли пороговую напряженность поля для возникновения эмиссии и долговременную стабильность эмиссионного тока для катода с CN-наноструктурами. Пороговая напряженность поля, измеренная при расстоянии катод–анод 300; 500; 700 и 900 µm, составила соответственно 1.56; 1.48; 1.2 и 1.44 V/µm.

Долговременную стабильность эмиссионного тока CN-наноструктур изучали при давлении 10^{-9} MPa, расстоянии катод–анод 700 µm при постоянной напряженности поля 1.36 V/µm в течение 103 h (рис. 4). Светоизлучающий элемент с диагональю 2.5 cm светился равномерно по всей поверхности при эмиссионном токе 100–200 µA. Флуктуации эмиссионного тока на начальном участке могут быть связаны с влиянием резкого приложения электрического поля. В дальнейшем, как видно из рис. 4, CN-нановолокна показывают хорошую стабильность эмиссионных характеристик, и флуктуации тока эмиссии при 200 µA составляют не более 10% за весь период измерения.

Ранее [8] сообщалось, что пороговая напряженность поля для углеродных нанотрубок, выращенных на натровом стекле, составляет 3.4–3.6 V/µm. Наши результаты показывают, что CN-наноструктуры имеют более высокие эмиссионные характеристики по сравнению с углеродными нанотрубками. Такое различие в величине прикладываемого поля может быть результатом наличия дефектных участков в структуре CN-нанотрубок и нановолокон [9]. В случае углеродных нанотрубок эмиссия электронов обычно происходит с вершины нанотрубки [10]. Однако в случае CN-наноструктур мы полагаем, что, помимо эмиссии электронов с вершин нанотрубок и нановолокон, эмиссия происходит также и с дефектов на боковых стенках CN-наноструктур аналогично [11].

Выводы

Исследованы эмиссионные характеристики CN-нановолокона, синтезированных в газостате. По результатам EELS содержание азота в наноструктурах составляет до 13%. При измерении эмиссионных характеристик CNнаноструктуры показали пороговую напряженность поля 1.4 V/µm, что является одним из лучших результатов для CN-наноструктур. Светоизлучающий элемент с размером диагонали 1 in с использованием катода с CNнаноструктурами при испытании на долговременную стабильность эмиссионных показателей продемонстрировал падение тока эмиссии не более 10% за 100 h тестирования.

- 1. S. Iijima, Nature (London) 354, 6438, 56 (1991).
- 2. M. Hirakaw, S. Sonoda, C. Tanaka, H. Murakami, H. Yamakawa, Applied Surface Science 169–170, 662 (2001).
- 3. R. Kurt, J.M. Bonard, A. Karimi, Thin Solid Films 398–399, 193 (2001).
- 4. V.D. Blank, I.G. Gorlova, J.L. Hutchison, N.A. Kiselev, A.B. Ormont, E.V. Polyakov, J. Sloan, D.N. Zakharov, S.G. Zybtsev, Carbon 38, 1217 (2000).

- 5. V.D. Blank, E.V. Polyakov, D.V. Batov, B.A. Kulnitskiy, U. Bangert, A. Gutierrez-Sosa, A.J. Harvey, A. Seepujak, Diamond and Related Materials **12**, 864 (2003).
- 6. Z.J. Zhang, S. Fan, C.M. Lieber, Appl. Phys. Lett. 56, 2582 (1995).
- 7. Y.K. Yap, K. Sida, Y.Wada, M. Yoshimura, Y. Mori, T. Sasaki, Diamond and Related Materials 9, 1228 (2000).
- 8. *Y.D. Lee, D.J. Lee, Y.H. Lee, J.E. Yoo, J.H. Park, B.C. Kim, B.K. Ju*, Proc. IDW'2002, December 4–6, 2002, Hiroshima, Japan, p. 1093.
- 9. M. Terrones, H. Terrones, N. Grobert, W.K. Hsu, Y.Q. Zhu, J.P. Hare, W. Kroto, D.R.M. Walton, Ph. Kohler-Redlich, M. Rühle, J.P. Zhang, A.K. Chaatham, Appl. Phys. Lett. **75**, 3932 (1999).
- 10. N. Jiang, R. Koie, T. Inaoka, Y. Shintani, K. Nishimura, A. Hiraki, Appl. Phys. Lett. 81, 526 (2002).
- 11. D.Y. Zhong, G.Y. Zhang, S. Liu, T. Sakurai, E.G. Wang, Appl. Phys. Lett. 80, 506 (2002).

D.V. Batov, V.D. Blank, E.V. Polyakov, B.A. Kulnitsky, B.K. Ju

CARBON-NITROGEN NANOTUBES FORMED IN GASOSTAT AND THEIR UTILIZATION AS COLD CATHODES

The carbon-nitrogen (CN) nanofibers formed by HIP processes have been investigated. Diameter of nanofibers was 100–150 nm. Nitrogen content of nanostructures determined by the EELS method equals to 13%. The turn-on fields were about 1.4 V/ μ m, this is the best result for the CN nanostructures fitting well the better values for carbon nanotubes. The time reliability and light emission tests were carried out for above 100 h and the current fluctuation was found to be less than 10%.

Fig. 1. SEM images of CN nanostructures: $a - \times 4000$, $\delta - \times 18000$

Fig. 2. TEM images of CN nanostructures: a – beads-like nanotubes, δ – bamboo-like nanofibers, e – nanotubes with strongly corrugated walls

Fig. 3. IR-spectrum of CN nanostructures

Fig. 4. Field emission lifetime (*I* vs time) of CN nanofibers tested with applied voltage of 1500 V